










	<h2>SI3467DV-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3467DV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.8A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3467DV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 17585 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3467DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.8A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	17585 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	15 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 3.8A (Ta) 1.14W (Ta) Surface Mount 6-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.14W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	54 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI3467DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3467DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3467DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3467DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3469DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3469DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3467DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3467DV VISHAY SI3467DV VISHAY</p>
 <p>SI3469DV-T1 VISHAY SI3469DV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3467DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3469DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3467DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.8A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

SI3460BDV-T1-E3	SI3460BDV-T1-E3	SI3460BDV-T1-GE3	SI3460BDV-T1-GE3	SI3460DDV
SI3460DDV-T1-GE3	SI3460DDV-T1-GE3	SI3460DV	SI3460DV-T1	SI3460DV-T1-E3
SI3460DV-T1-E3	SI3460DV-T1-GE3	SI3460DV-T1-GE3	SI3461DV-T1-E3	SI3461DVT1-GE3
SI3464DV	SI3464DV-T1-GE3	SI3464DV-T1-GE3	SI3465DV-T1-E3	SI3465DV-T1-E3
SI3465DV-T1-GE3	SI3465DV-T1-GE3	SI3467DV	SI3467DV-T1-E3	SI3467DV-T1-E3
SI3467DV-T1-GE3	SI3469DV-T1	SI3469DV-T1-E3	SI3469DV-T1-E3	SI3469DV-T1-GE3
SI3469DV-T1-GE3	SI3471DV-T1-E3	SI3473CDV-T1-E3	SI3473CDV-T1-E3	SI3473CDV-T1-GE3
SI3473CDV-T1-GE3	SI3473DDV-T1-GE3	SI3473DV-T1-E3	SI3473DV-T1-E3	SI3473DV-T1-GE3
SI3473DV-T1-GE3	SI3474DV-T1-GE3	SI3474DV-T1-GE3	SI3475DV-T1-E3	SI3475DV-T1-E3
SI3475DV-T1-GE3	SI3475DV-T1-GE3	SI3476DV-T1-E3	SI3476DV-T1-GE3	SI3476DV-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited